

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

Заявление на замещение вакантной должности
старшего научного сотрудника, кандидата наук
в лаборатории фотоэлектрических преобразователей
Вакансия VAC 95197

Тематика исследований

Прикладные научные исследования в области получения высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей (концентраторных солнечных элементов, преобразователей лазерного излучения, термофотоэлектрических преобразователей ИК излучения), включая кристаллизацию соединений методом жидкофазной эпитаксии, диффузионное получение p-n переходов.

Трудовая деятельность

Организация и проведение прикладных научных исследований в области получения фотоэлектрических преобразователей методом жидкофазной эпитаксии и диффузионного легирования в составе коллектива лаборатории фотоэлектрических преобразователей, включая:

- Обсуждение конкретных планов и направлений исследований в области жидкофазного выращивания полупроводниковых соединений. Непосредственное участие к моделированию изотерм растворимости новых полупроводниковых систем;
- Разработка и реализация технологических подходов получения высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей. Оптимизация процессов кристаллизации, диффузионного легирования, получения омических контактов и др.
- Написание и подготовка к публикации работ в области получения высокоэффективных фотоэлектрических преобразователей к печати в ведущих российских и мировых научных журналах;
- Выполнение расчетов и подготовка отчетов по проектам фундаментальных исследований.

Требования к кандидату

- Диплом кандидата наук по специальности 01.04.10 – «Физика полупроводников»
- Стаж научной работы по специальности не менее 5 лет.
- Индекс Хирша по БД Web of Science не менее 8.
- Наличие публикаций в журналах, индексируемых Scopus и WoS не менее 10 за последние 5 лет по теме исследований.
- Опыт работы на установках жидкофазной эпитаксии и диффузионного легирования полупроводниковых структур из газовой фазы, практическое применение постростовой технологии получения фотоэлектрических преобразователей. Свободное владение программами Excel, Origin для моделирования и обработки результатов эксперимента по исследованию фазовых диаграмм кристаллизации и диффузионных профилей легирования полупроводниковых структур.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 31 395 руб.

СТАВКА: 1.0

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 15 000 руб.

Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.